

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ПРИМЕСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СОСТОЯНИЯ
АТОМОВ Tl И Sn В ТВЕРДОМ РАСТВОРЕ $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}$

© С. А. Немов, Ф. С. Насрединов, Р. В. Парфеньев,
Ю. И. Равич, А. В. Черняев, Д. В. Шамшур

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021 Санкт-Петербург, Россия
(Поступило в Редакцию 20 сентября 1995 г.)

В работах [1,2] на основании экспериментальных данных по кинетическим явлениям, сверхпроводимости и эффекту Мессбауэра высказано предположение о том, что донорные уровни олова в PbTe и твердом растворе $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}$ находятся под уровнем Ферми и потому не оказывают влияния на электронные свойства указанных материалов.

В настоящей работе продолжены исследования [2], направленные на обнаружение электронных состояний Sn в твердых растворах $(\text{PbTe})_{1-x}(\text{PbS})_x$. С целью приближения примесных состояний олова к уровню Ферми ε_F увеличено содержание PbS в твердом растворе до $x = 0.10$. Положение уровня Ферми, как и ранее [2], фиксировалось введением примеси Tl ($N_{\text{Tl}} = 2 \text{ at.\%}$), создающей в твердых растворах $(\text{PbTe})_{1-x}(\text{PbS})_x$ на фоне спектра валентной зоны полосу резонансных состояний, энергетическое положение ε_{Tl} которой слабо зависит от состава матрицы ($\varepsilon_{\text{Tl}} \approx 0.20 - 0.15 \text{ eV}$ [3] при низких температурах). Олово вводилось в шихту образцов в виде SnTe в количестве 0.5–3 mol %. Для повышения чувствительности мессбауэровской спектроскопии использовался препарат, обогащенный изотопом ^{119}Sn до 90 %. Состав исследованных образцов соответствовал химической формуле $\text{Pb}_{0.98-y}\text{Tl}_{0.02}\text{Sn}_y\text{Te}_{0.9}\text{S}_{0.1}$. Образцы были изготовлены металлокерамическим методом и подвергнуты гомогенизирующему отжигу (использованная технология подробно описана в [2]). Основные экспериментальные результаты приведены на рис. 1–3 и в таблице.

Сопоставление полученных для $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl},\text{Sn}$ результатов с данными для образцов PbTe:Tl [3–7], твердого раствора $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}:\text{Tl},\text{Sn}$ [2] и PbTe:Na [8] обнаруживает следующие особенности. По сравнению с образцами, исследованными в [2], в твердом растворе с содержанием PbS $x = 0.1$ заметно (\sim в 2 раза) снизилась концентрация дырок (определенная из коэффициента Холла R при 77 K) до значений $p \approx (4-7) \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ (см. таблицу). Отметим,

Номер п/п	N_{Sn} , at. %	u (77 K), $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$	u (300 K), $\text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$	p_{77} , 10^{19} cm^{-3}	R_{300}/R_{77}	u_{300}/u_{77}
1	0.5	48	39	4.5	1.0	0.8
2	1.0	59	39	3.5	0.8	0.7
3	3.0	69	32	6.9	1.7	0.5

что уменьшение p согласуется с увеличением коэффициента термоэдс S (рис. 1) и увеличением холловской подвижности (см. таблицу) в диапазоне температур 77–400 К. При этом зависимость коэффициента Холла от температуры стала более резкой, заметно приблизившись к $R(T)$ в PbTe:Na .

Кроме того, в исследованных образцах отсутствует переход в сверхпроводящее состояние при температурах 0.6–4.2 К, характерный для образцов PbTe:Tl [6], $\text{PbTe}_{1-x}\text{S}_x:\text{Tl}$ [9] и $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}:\text{Tl,Sn}$ [2]. Наблюдается лишь начало перехода в сверхпроводящее состояние образца с наименьшим содержанием олова ($N_{\text{Sn}} = 0.5$ at. %), которое разрушается магнитным полем (его удельное сопротивление уменьшается приблизительно на 20% при $T = 0.6$ К (рис. 3)).

В рамках модели резонансных состояний Tl, с успехом использовавшейся для объяснения практически всей совокупности экспериментальных данных в полупроводниковых материалах на основе $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ с примесью Tl [3], отмеченные особенности экспериментальных результатов для образцов $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl,Sn}$ однозначно свидетельствуют

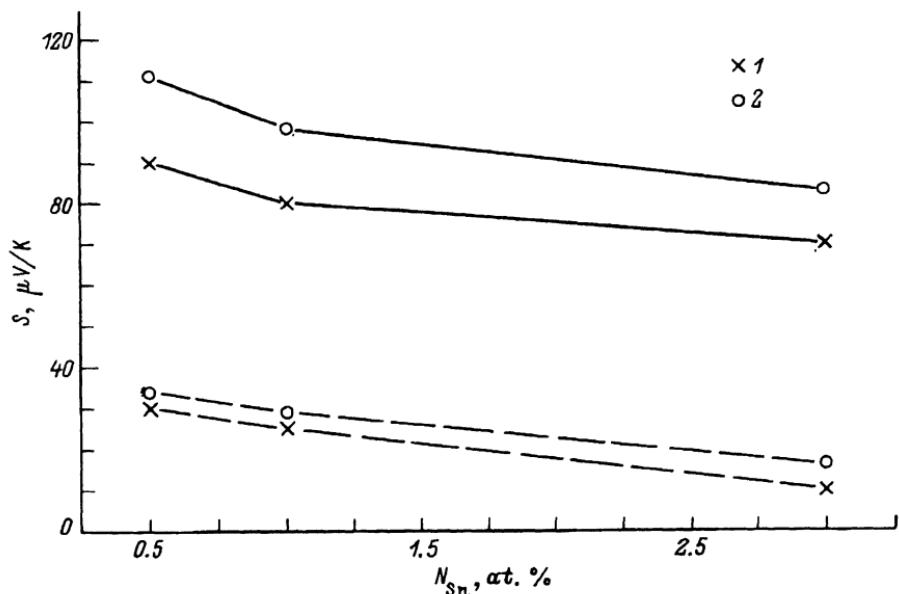


Рис. 1. Зависимости коэффициента термоэдс S от содержания Sn в образцах твердых растворов $(\text{PbTe})_{1-y}(\text{PbS})_y:\text{Tl,Sn}$ при комнатной температуре (сплошные линии) и при $T = 120$ К (штриховые линии).

у: 1 — 0.05, 2 — 0.1.

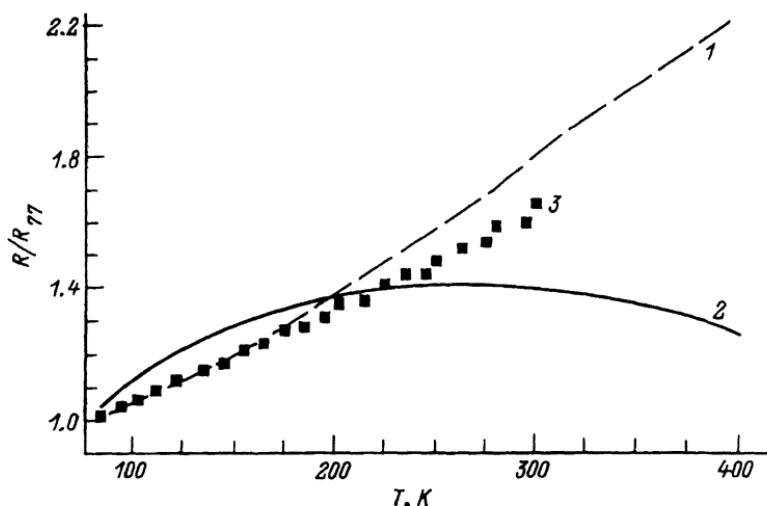


Рис. 2. Относительное изменение коэффициента Холла R/R_{77} с температурой в PbTe:Na [8] (1), PbTe:Tl [4] (2) и $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl},\text{Sn}$ (3).

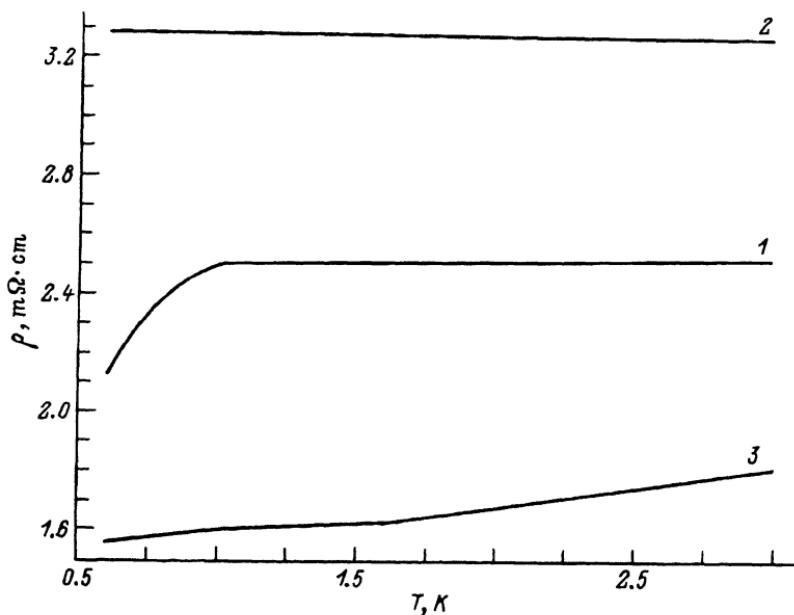


Рис. 3. Температурные зависимости удельного сопротивления образцов $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Te}_{0.9}\text{S}_{0.1}$, легированных 2 at.% Tl.
x: 1 — 0.005, 2 — 0.010, 3 — 0.030.

ют об ослаблении роли квазилокальных примесных состояний Tl и резонансного рассеяния дырок в эти состояния. Подобный эффект может быть объяснен, если предположить, что в твердом растворе $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl},\text{Sn}$ электронные состояния олова (по-видимому, генетически связанные с $5s^2$ -состояниями атома Sn) «подтягиваются» из глубины валентной зоны к уровню Ферми и увеличивают степень заполнения электронами примесных состояний Tl.

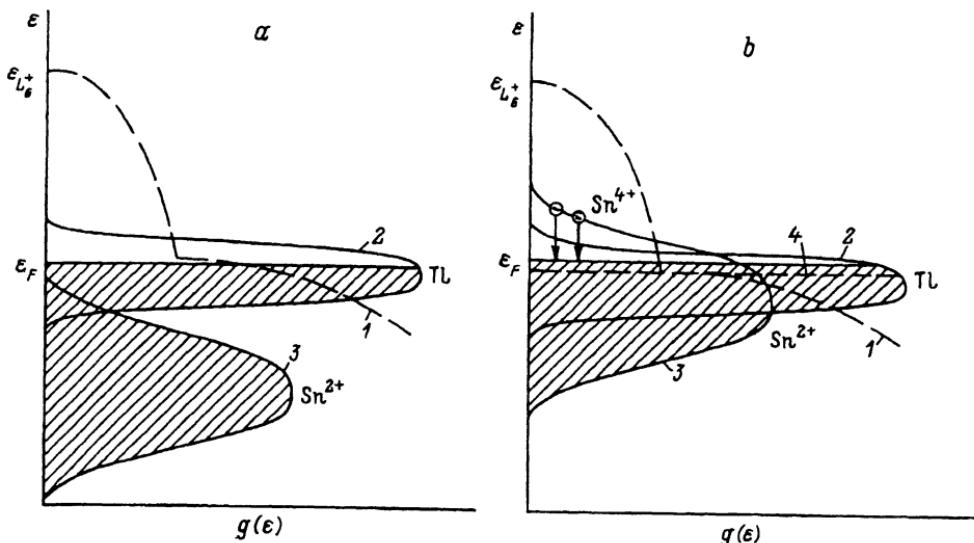


Рис. 4. Качественный вид плотности электронных состояний $g(\varepsilon)$ примесей Sn и Tl в твердых растворах $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}:\text{Tl},\text{Sn}$ (а) и $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl},\text{Sn}$ (б).
 1 — функция плотности зонных состояний, 2 — плотность резонансных состояний Tl,
 3 — плотность электронных состояний Sn, 4 — положение уровня Ферми в образцах
 твердого раствора с $y = 0.1$, легированного одной примесью Tl. Заштрихованы заполненные
 электронами состояния. Стрелками схематично изображен переход электронов с атомов Sn
 в валентную зону и на примесные состояния Tl.

Рассмотрим более подробно это утверждение. В халькогенидах свинца примесь Tl создает полосу квазилокальных состояний на фоне спектра валентной зоны [3]. Опыты по дополнительному легированию $\text{PbTe}:\text{Tl}$ электроактивной примесью (акцептор — Na, донор — избыток Pb) показали, что в полосе Tl содержатся два электронных состояния на атом таллия [10]. Если учесть, что Tl является элементом III группы таблицы Д.И. Менделеева и замещает двухвалентный Pb в халькогенидах свинца, то ясно, что атомы Tl отдают два своих электрона на химические связи с халькогеном (третий валентный электрон остается на атоме Tl). В результате полоса таллия оказывается наполовину заполненной своими электронами. Но поскольку она расположена ниже вершины валентной зоны, эту полосу заполняют электроны из вышележащих состояний валентной зоны, образуя в валентной зоне дырки и увеличивая заполнение резонансных состояний Tl электронами. Коэффициент заполнения полосы Tl электронами равен

$$k_e = 0.5 + p/2N_{\text{Tl}}, \quad (1)$$

где p — полная концентрация дырок в валентной зоне.

Оценки k_e по формуле (1) для халькогенидов свинца и твердого раствора $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}$, легированных 2 at.% Tl, показывают, что величина $k_e \approx 2/3$, так что уровень Ферми ε_F в этих системах расположен выше пика плотности резонансных состояний Tl (как это показано на рис. 4). Примесные состояния Sn как в PbTe, так и в $(\text{PbTe})_{0.95}(\text{PbS})_{0.05}$ расположены под уровнем Ферми (рис. 4).

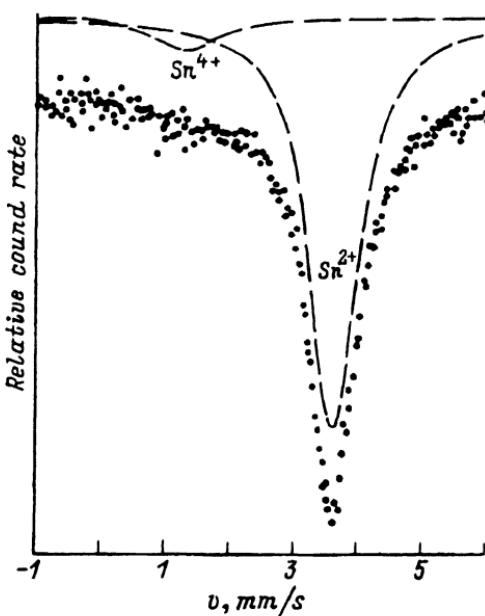


Рис. 5. Мессбауэровский спектр образца $\text{Pb}_{0.97}\text{Sn}_{0.01}\text{Tl}_{0.02}\text{Te}_{0.9}\text{S}_{0.1}$ при температуре 77 К.

Штриховыми линиями показано разложение спектра на компоненты.

В твердом растворе $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}$ примесные состояния Sn приближаются из глубины валентной зоны к уровню Ферми, и размытый пик плотности электронных состояний Sn своим верхним краем пересекает ε_F . При этом электроны с атомов Sn переходят на свободные места в полосе Tl; тем самым увеличивается заполнение ее электронами, т.е. уровень Ферми дырок в системе и концентрация дырок в валентной зоне понижаются в согласии с экспериментом. Кроме того, увеличение заполнения полосы Tl электронами вызывает снижение плотности примесных состояний на уровне Ферми, и тем самым уменьшение влияния резонансных состояний таллия на все кинетические коэффициенты приводит, в частности, к исчезновению сверхпроводящего перехода при температурах $T \geq 0.6$ К.

Отметим, что «сброс» электронов с атомов Sn^{2+} должен сопровождаться появлением атомов олова в зарядовом состоянии Sn^{4+} .

Оценки, сделанные на основе уравнения электронейтральности кристалла, с использованием данных [6] по сверхпроводящим свойствам образцов PbTe:Tl с различным заполнением полосы Tl электронами показывают, что значительная часть атомов Sn в твердом растворе $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl}, \text{Sn}$ может изменить свое зарядовое состояние. С целью проверки сделанных оценок были измерены мессбауэровские спектры олова ^{119}Sn при 77 К. Как видно из рис. 5, в мессбауэровском спектре образца твердого раствора с $N_{\text{Sn}} = 1 \text{ at.\%}$ наблюдаются две линии с изомерными сдвигами 3.5 и 1.3 mm/s, характерными для зарядовых состояний Sn^{2+} (нейтральное состояние относительно подрешетки свинца) и Sn^{4+} (двукратно заряженное состояние) соответственно. Причем, судя по соотношению интенсивностей этих линий, основная часть атомов олова находится в нейтральном состоянии, а небольшая

их часть (около 7%) отдала в полосу резонансных состояний по два электрона. Важной особенностью мессбауэровских данных является отсутствие линии, соответствующей однократно заряженному состоянию олова Sn^{3+} .

Таким образом, данные по эффекту Мессбауэра подтверждают донорный характер примесных состояний Sn и свидетельствуют о том, что олово в твердых растворах $(\text{PbTe})_{1-x}(\text{PbS})_x$ при $x > 0.1$ является центром с отрицательной корреляционной энергией.

В заключение отметим, что полученные в работе экспериментальные данные свидетельствуют о расположении примесных состояний олова на фоне валентной зоны твердого раствора $(\text{PbTe})_{0.9}(\text{PbS})_{0.1}:\text{Tl},\text{Sn}$ в непосредственной близости от уровня Ферми.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 95-02-03863-а) и частично при поддержке INTAS-93 (проект 1555).

Список литературы

- [1] Кайданов В.И., Немов С.А., Зайцев А.М. ФТП **19**, 2, 268 (1985).
- [2] Немов С.А., Насрединов Ф.С., Парфеньев Р.В., Житинская М.К., Черняев А.В., Шамшур Д.В. ФТТ **38**, 2, 214 (1996).
- [3] Кайданов В.И., Немов С.А., Равич Ю.И. ФТП **26**, 2, 201 (1992).
- [4] Вейс А.Н., Кайданов В.И., Немов С.А., Емелин С.Н., Ксендззов А.Я., Шалабутов Ю.К. ФТП **13**, 1, 185 (1979).
- [5] Вейс А.Н., Немов С.А. ФТП **15**, 6, 1237 (1981).
- [6] Кайданов В.И., Немов С.А., Парфеньев Р.В., Шамшур Д.В. Письма в ЖЭТФ **35**, 12, 517 (1982).
- [7] Немов С.А., Равич Ю.И., Зайцев А.М. ФТП **19**, 4, 636 (1985).
- [8] Черник И.А., Кайданов В.И., Виноградова М.Н., Коломоец Н.В. ФТП **2**, 6, 773 (1968).
- [9] Житинская М.К., Немов С.А., Парфеньев Р.В., Шамшур Д.В. ФТТ **32**, 1, 122 (1990).
- [10] Кайданов В.И., Немов С.А., Равич Ю.И., Зайцев А.М. ФТП **17**, 9, 1613 (1983).